3　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（二〇〇六）で定める測定方法により測定した場合に、移動量が二メートル以上の直線軸のうち、ミリメートルで表したいずれか一軸以上の直線軸の位置決め精度が、次の式により算出した数値以下のもの

〇・〇〇四五＋〇・〇〇七×（Ｌ（メートルで表した直線軸の移動量）－二）

4　パラレルメカニズムのもの

第五条第二号ロ（三）中「ときの」を「場合に、いずれか一軸以上の」に改め、同号ヘ（五）の次に次のように加える。

（六）　義歯

第五条第三号中「又はこれらの部分品」を削り、同条第七号を次のように改める。

七　別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品

第六条第一号ト（一）中「最大」を「シングルエンド方式の最大」に、「二〇〇を超えるもの」を「五〇〇以上のもの」に改め、同号ト（二）を次のように改める。

（二）　シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が一秒あたり二〇〇ギガビット以上のもの

第六条第二号ハ（四）中「三七・五ギガヘルツ」を「三七ギガヘルツ」に改め、「ナノワット」の下に「（マイナス七〇ディービーエム）」を加え、同号ハ（五）中「三七・五ギガヘルツ」を「三七ギガヘルツ」に、「〇・二五ワット（二四ディービーエム）」を「一・〇ワット（三〇ディービーエム）」に改め、「のうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの」を削り、同号ハ（六）中「を超え、」を「超七五ギガヘルツ以下であって、」に、「〇・一ナノワット」を「三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）」に改め、「超えるもの」の下に「のうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの」を加え、同号ハに次のように加える。

（七）　動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、平均出力値が一〇ミリワット（一〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

（八）　動作周波数が九〇ギガヘルツを超え、平均出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

第六条第二号ヲ（一）及び（二）中「キロヘルツ未満」の下に「のいずれかの周波数帯域」を加え、同号ワ（一）中「三一二ピコ秒」を「一五六ピコ秒」に改め、同号ワ（二）中「三・二ギガヘルツ」を「四・八ギガヘルツ」に改め、同号ワ（六）及び（七）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同条第十二号イ中「無線周波数分析器であって、」を削り、同号ロ中「無線周波数分析器であって、」を削り、「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ハ中「無線周波数分析器であって、七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ　次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　実時間帯域幅が八五メガヘルツを超えるもの

（二）　一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの

第六条第十二号に次のように加える。

ホ　周波数マスクトリガー機能を有するものであって、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えることができるもの

第六条第十三号イ及びロ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ハ（一）を次のように改める。

（一）　削除

第六条第十三号ハ（二）中「三・二ギガヘルツ」を「四・八ギガヘルツ」に改め、同号ハ（六）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ニ（一）及び（二）中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、「キロヘルツ未満」の下に「のいずれかの周波数帯域」を加え、同号ホ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同条第十四号イ中「七〇ギガヘルツ」を「七五ギガヘルツ」に改め、同号ロ中「七〇ギガヘルツ」を「一一〇ギガヘルツ」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イの次に次のように加える。

ロ　七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワット（〇ディービーエム）を超えるもの

ハ　五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの（イ又はロに該当するものを除く。）

第六条第十五号イ中「七〇ギガヘルツ」を「一一〇ギガヘルツ」に改め、同条第十七号イ（二）中「第二十号又は第二十一号に該当する材料を化学的に反応させることにより化合物半導体の結晶を」を「アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル」に改め、同号ロ（一）を次のように改める。

（一）　削除

第六条第十七号ロ（二）を次のように改める。

（二）　水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの

第六条第十七号ロ（四）を次のように改める。

（四）　加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが六五キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が四五ミリアンペア以上のもの

第六条第十七号ロに次のように加える。

（五）　六〇〇度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの

第六条第十七号ト中「又はレチクル」を削り、同号ト（二）を次のように改める。

（二）　位相シフト膜を有する多層マスクであって、次のいずれかに該当するもの（（一）に該当するもの及び第一号から第八号の三までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

1　複屈折率が七ナノメートル毎センチメートル未満のガラスを用いたマスク基板材料から製造されたもの

2　光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるように設計したもの

第六条第十七号ト（三）を削り、同号チを同号ヌとし、同号トの次に次のように加える。

チ　レチクルであって、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

リ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の三までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

第六条第十九号イ中「ポジ形」を削り、「二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計した」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号イに次のように加える。

（一）　一五ナノメートル以上二四五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したポジ型レジスト

（二）　一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用することができるように設計したレジスト